

(19) 世界知的所有機関
国際事務局(43) 国際公開日
2005年1月20日 (20.01.2005)

PCT

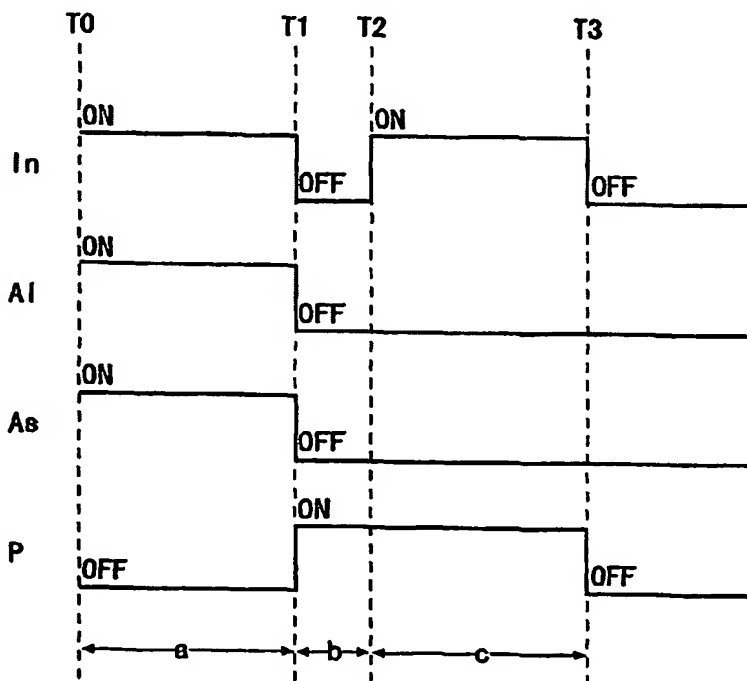
(10) 国際公開番号
WO 2005/006421 A1

- (51) 国際特許分類: H01L 21/203
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/006144
- (22) 国際出願日: 2004年4月28日 (28.04.2004)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2003-274441 2003年7月15日 (15.07.2003) JP
- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 株式会社日鉄マテリアルズ (NIKKO MATERIALS CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1058407 東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 高草木 操 (TAKAKUSAKI, Misao) [JP/JP]; 〒3358502 埼玉県戸田市新曽南3丁目17番35号 株式会社日鉄マテリアルズ 戸田工場内 Saitama (JP). 金井 進 (KANAI, Susumu) [JP/JP]; 〒3358502 埼玉県戸田市新曽南3丁目17番35号 株式会社日鉄マテリアルズ 戸田工場内 Saitama (JP).
- (74) 代理人: 荒船 博司 (ARAFUNE, Hiroshi); 〒1620832 東京都新宿区岩戸町18番地 日交神楽坂ビル5階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,

/続業有/

(54) Title: EPITAXIAL GROWTH PROCESS

(54) 発明の名称: エピタキシャル成長方法



(57) Abstract: A epitaxial growth process for forming a semiconductor thin film having a heterojunction of a III-V compound semiconductor by a molecular beam epitaxial growth process comprises a first step for forming a first compound semiconductor layer through irradiation with a molecular beam of at least one kind of group III elements and a molecular beam of a first group V element, a second step for stopping irradiation with the molecular beam of group III elements and the molecular beam of the first group V element and interrupting the growth until the supply of the first group V element becomes one tenth or less of the supply in the first step, and a third step for forming a second compound semiconductor layer different from the first compound semiconductor on the first compound semiconductor layer through irradiation with a molecular beam of at least one kind of group III elements and a molecular beam of a second group V element.

(57) 要約: 分子線エピタキシャル成長法によりIII-V族系化合物半導体のヘテロ接合を有する半導体薄膜を形成するエピタキシャル成長方法であって、少なくとも一種以上III族元素の分子線とを照射して第1の化合物半導体層を形成する第1の工程と、前記III族元素の分子線

/続業有/

導体薄膜を形成するエピタキシャル成長方法であって、少なくとも一種以上III族元素の分子線とを照射して第1の化合物半導体層を形成する第1の工程と、前記III族元素の分子線